Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

1. Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b Ustawy;

1. **Rudno-Rudziński, W.**, Sęk, G., Ryczko, K., Syperek, M., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
   Optical properties and energy transfer in InGaAsN quantum well InAs quantum dots tunnel injection structures for 1.3 µm emission
   (2009) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, **206** (5), pp. 826-829.
   Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 27 Impact Factor: 1,228

   Rudno-Rudziński, W. – koncepcja badań, pomiary fotoodbicia, fotoluminescencji oraz wzbudzania luminescencji, analiza danych doświadczalnych, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu
   Sęk, G. – udział w interpretacji rezultatów, udział w przygotowaniu manuskryptu
   Ryczko, K. – obliczenia struktury pasmowej
   Syperek, M. – udział w pomiarach wzbudzania fotoluminescencji
   Misiewicz, J. – nadzór merytoryczny nad częścią spektroskopową prac, dyskusja wyników
   Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A. – wzrost MBE i processing badanych próbek

2. **Rudno-Rudziński, W.**, Sęk, G., Ryczko, K., Syperek, M., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
   Room temperature free carrier tunneling in dilute nitride based quantum well - quantum dot tunnel injection system for 1.3 µm
   (2009) Applied Physics Letters, **94** (17), art. no. 171906.
   Cytowania: 24 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 3,554

   Rudno-Rudziński, W. – udział w powstaniu koncepcji badań, wykonanie pomiarów fotoodbicia, fotoluminescencji oraz wzbudzania luminescencji, analiza i interpretacja rezultatów, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu
   Sęk, G. – udział w powstaniu koncepcji badań, udział w pomiarach wzbudzania fotoluminescencji, udział w dyskusji i interpretacji uzyskanych rezultatów, udział w przygotowaniu manuskryptu
   Ryczko, K. – obliczenia struktury pasmowej
   Syperek, M. – pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie
   Misiewicz, J., – nadzór merytoryczny nad częścią spektroskopową prac, dyskusja wyników
   Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A. – wzrost MBE i processing badanych próbek

3. **Rudno-Rudziński, W.**, Ryczko, K., Sęk, G., Syperek, M., Misiewicz, J., Pavelescu, E.-M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
   Optical methods used to optimize semiconductor laser structures with tunnel injection from quantum well to InGaAs/GaAs quantum dots
   (2009) Optica Applicata, **39** (4), pp. 923-932.

Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 13 Impact Factor: 0,358

Rudno-Rudziński, W. – wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, udział w powstaniu koncepcji badań, wykonanie pomiarów fotoodbicia, fotoluminescencji oraz wzbudzania luminescencji, analiza danych doświadczalnych, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi
Ryczko, K. – obliczenia struktury pasmowej
Sęk, G. – dyskusja uzyskanych rezultatów, udział w przygotowaniu manuskryptu
Syperek, M. – udział w pomiarach wzbudzania fotoluminescencji
Misiewicz, J. – nadzór na pomiarami i modelowaniem
Pavelescu, E.-M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P. – wzrost MBE i processing badanych próbek

4. **Rudno-Rudziński, W.**, Ryczko, K., Sęk, G., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
Carrier wavefunction control in a dilute nitride-based quantum well - A quantum dot tunnel injection system for 1.3 µm emission
(2011) Semiconductor Science and Technology, **26** (8), art. no. 085004.
Cytowania: 3 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 1,723

Rudno-Rudziński, W. – koncepcja badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, wykonanie pomiarów fotoodbicia, analiza danych doświadczalnych, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi,
Ryczko, K. – obliczenia struktury pasmowej
Sęk, G. – nadzór na pomiarami spektroskopowymi, udział w przygotowaniu manuskryptu
Misiewicz, J. – kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A. – wzrost MBE i processing badanych próbek

5. Syperek, M., Andrzejewski, J., **Rudno-Rudziński, W.**, Sęk, G., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Influence of electronic coupling on the radiative lifetime in the (In,Ga)As/GaAs quantum dot-quantum well system
(2012) Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, **85** (12), art. no. 125311.
Cytowania: 22 Punktacja MNiSW: 35 Impact Factor: 3,767

Syperek, M. – zaplanowanie i wykonanie wszystkich badań optycznych, oprócz pomiaru fotoodbicia, zaproponowanie koncepcji teoretycznej dla interpretacji wyników badań oraz napisanie pierwszej wersji manuskryptu
Andrzejewski, J. – obliczenia struktury pasmowej
Rudno-Rudziński, W. – zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów fotoodbicia oraz analiza ich wyników, dyskusja rezultatów, przygotowanie drugiej wersji manuskryptu i odpowiedzi do recenzentów
Sęk, G. – nadzór na pomiarami i modelowaniem
Misiewicz, J. – kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P. – wzrost MBE i processing badanych próbek

6. **Rudno-Rudziński, W**., Sęk, G., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Lelarge, F., Rousseau, B.
Electronic structure and optical properties of 1.55 µm emitting InAs/InGaAsP quantum dash tunnel injection structures
(2012) Semiconductor Science and Technology, 27 (10), art. no. 105015.
Cytowania: 7 Punktacja MNiSW: 30 Impact Factor: 1,921

Rudno-Rudziński, W. – udział w powstaniu koncepcji badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, wykonanie pomiarów fotoodbicia, fotoluminescencji oraz wzbudzania luminescencji, analiza danych doświadczalnych, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi
Sęk, G. – nadzór na pomiarami i modelowaniem, udział w powstaniu koncepcji badań, dyskusja wyników
Andrzejewski, J. – obliczenia struktury pasmowej
Misiewicz, J. – kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Lelarge, F., Rousseau, B. – wzrost MBE i processing badanych próbek

7. **Rudno-Rudziński, W.**, Syperek, M., Andrzejewski, J., Maryński, A., Misiewicz, J., Somers, A., Höfling, S., Reithmaier, J.P., Sęk, G.
Carrier delocalization in InAs/InGaAlAs/InP quantum-dash-based tunnel injection system for 1.55 µm emission
(2017) AIP Advances, **7** (1), art. no. 015117.
Cytowania: 9 Punktacja MNiSW: 25 Impact Factor: 1,653

Rudno-Rudziński, W. – koncepcja badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, wykonanie pomiarów fotoodbicia, fotoluminescencji oraz wzbudzania luminescencji, analiza i interpretacja rezultatów
Syperek, M., Maryński, A. – pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie
Andrzejewski, J. – obliczenia struktury pasmowej
Misiewicz, J. – dyskusja wyników
Sęk, G. – udział w przygotowaniu manuskryptu, kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Somers, A., Höfling, S., Reithmaier, J.P., – wzrost MBE i processing badanych próbek

8. **Rudno-Rudziński, W.,** Biegańska, D., Misiewicz, J., Lelarge, F., Rousseau, B., Sęk, G.
Carrier diffusion as a measure of carrier/exciton transfer rate in InAs/InGaAsP/InP hybrid quantum dot-quantum well structures emitting at telecom spectral range
(2018) Applied Physics Letters, **112** (5), art. no. 051103.
Cytowania: 6 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,521

Rudno-Rudziński, W. – udział w powstaniu koncepcji badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, wstępne pomiary fotoluminescencji, analiza i interpretacja wyników
Biegańska, D. – pomiary luminescencji rozdzielonej przestrzennie, modelowanie wyników pomiaru równaniami dyfuzji
Misiewicz, J. – dyskusja wyników
Sęk, G. – udział w powstaniu koncepcji badań, udział w przygotowaniu manuskryptu, kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Lelarge, F., Rousseau, B., – wzrost MBE i processing badanych próbek

9. **Rudno-Rudziński, W**., Syperek, M., Maryński, A., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P., Schowalter, M., Gerken, B., Rosenauer, A., Sęk, G.
Control of Dynamic Properties of InAs/InAlGaAs/InP Hybrid Quantum Well-Quantum Dot Structures Designed as Active Parts of 1.55 µm Emitting Lasers
(2018) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, **215** (4), art. no. 1700455.
Cytowania: 7 Punktacja MNiSW: 25 Impact Factor: 1,606

Rudno-Rudziński, W. – udział w powstaniu koncepcji badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, pomiary widm fotoodbicia i fotoluminescencji, analiza i interpretacja wyników
Maryński, A. – pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie

Syperek, M. – udział w powstaniu koncepcji badań, pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie
Andrzejewski, J. – obliczenia struktury pasmowej
Misiewicz, J. – dyskusja wyników
Sęk, G. – udział w przygotowaniu manuskryptu, kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P. – wzrost MBE i processing badanych próbek
Schowalter, M., Gerken, B., Rosenauer, A., – wykonanie i analiza obrazów transmisyjnej mikroskopii tunelowej

10. **Rudno-Rudziński, W**., Syperek, M., Andrzejewski, J., Rogowicz, E., Eisenstein, G., Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P., Sęk, G.
Carrier transfer efficiency and its influence on emission properties of telecom wavelength InP-based quantum dot – quantum well structures
(2018) Scientific Reports, **8** (1), art. no. 12317.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 4,011

Rudno-Rudziński, W. – koncepcja badań, wiodąca rola w przygotowaniu manuskryptu, pomiary widm fotoodbicia i fotoluminescencji, analiza danych doświadczalnych, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi
Syperek, M. – modelowanie z wykorzystaniem równań kinetycznych
Andrzejewski, J. – obliczenia struktury pasmowej
Rogowicz, E. – pomiary fotoluminescencji w funkcji temperatury
Sęk, G – udział w przygotowaniu manuskryptu, kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w pracy
Eisenstein, G. – konsultacje modelu równań kinetycznych
Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P. – wzrost MBE i processing badanych próbek, badania strukturalne

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2).

1. Rudno-Rudziński, W., Syperek, M., Andrzejewski, J., Rogowicz, E., Eisenstein, G., Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P., Sęk, G.
Carrier transfer efficiency and its influence on emission properties of telecom wavelength InP-based quantum dot – quantum well structures
(2018) Scientific Reports, 8 (1), art. no. 12317.
Cytowania: 1 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 4,011
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

2. Rudno-Rudziński, W., Syperek, M., Maryński, A., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Bauer, S., Sichkovskyi, V.I., Reithmaier, J.P., Schowalter, M., Gerken, B., Rosenauer, A., Sęk, G.
Control of Dynamic Properties of InAs/InAlGaAs/InP Hybrid Quantum Well-Quantum Dot Structures Designed as Active Parts of 1.55 µm Emitting Lasers
(2018) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 215 (4), art. no. 1700455.
Cytowania: 7 Punktacja MNiSW: 25 Impact Factor: 1,606
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

3. Rudno-Rudziński, W., Biegańska, D., Misiewicz, J., Lelarge, F., Rousseau, B., Sęk, G.
Carrier diffusion as a measure of carrier/exciton transfer rate in InAs/InGaAsP/InP hybrid quantum dot-quantum well structures emitting at telecom spectral range
(2018) Applied Physics Letters, 112 (5), art. no. 051103.
Cytowania: 4 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,521
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

4. Syperek, M., Andrzejewski, J., Rudno-Rudziński, W., Maryński, A., Sek, G., Misiewicz, J., Reithmaier, J.P., Somers, A., Höfling, S.
The issue of 0D-like ground state isolation in GaAs- and InP-based coupled quantum dots-quantum well systems
(2017) Journal of Physics: Conference Series, 906 (1), art. no. 012019.
Cytowania: 1 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: brak
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia

5. Rudno-Rudziński, W.
Quantum well-quantum dot tunnel structures as active material for telecom lasers [Struktury tunelowe studnia kwantowa-kropki kwantowe jako ośrodek czynny laserów telekomunikacyjnych]
(2017) Przegląd Elektrotechniczny, 93 (8), pp. 20-23.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 14 Impact Factor: brak
Praca przeglądowa jednoautorska

6. Rudno-Rudziński, W., Syperek, M., Andrzejewski, J., Maryński, A., Misiewicz, J., Somers, A., Höfling, S., Reithmaier, J.P., Sęk, G.
Carrier delocalization in InAs/InGaAlAs/InP quantum-dash-based tunnel injection system for 1.55 µm emission
(2017) AIP Advances, 7 (1), art. no. 015117.
Cytowania: 8 Punktacja MNiSW: 25 Impact Factor: 1,653
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

7. Dyksik, M., Motyka, M., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Misiewicz, J., Pucicki, D., Kosiel, K., Sankowska, I., Kubacka-Traczyk, J., Bugajski, M.
Optical Properties of Active Regions in Terahertz Quantum Cascade Lasers
(2016) Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 37 (7), pp. 710-719.
Cytowania: 5 Punktacja MNiSW: 25 Impact Factor: 2,540
Dyskusja wyników, udział w przygotowaniu manuskryptu

8. Gluba, L., Yastrubchak, O., Sęk, G., Rudno-Rudziński, W., Sadowski, J., Kulik, M., Rzodkiewicz, W., Rawski, M., Andrearczyk, T., Misiewicz, J., Wosinski, T., Zuk, J.
On the nature of the Mn-related states in the band structure of (Ga,Mn)As alloys via probing the E_1 and $E_1 + \Delta_1$ optical transitions
(2014) Applied Physics Letters, 105 (3), art. no. 032408.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,302
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia

9. Dusanowski, Ł., Syperek, M., Mrowiński, P., Rudno-Rudziński, W., Misiewicz, J., Somers, A., Höfling, S., Kamp, M., Reithmaier, J.P., Sęk, G.
Single photon emission at 1.55 µm from charged and neutral exciton confined in a single quantum dash
(2014) Applied Physics Letters, 105 (2), art. no. 021909.

Cytowania: 31 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,302
Projekt i konstrukcja układu pomiarowego, udział w przygotowaniu manuskryptu

10. Dusanowski, Ł., Syperek, M., Rudno-Rudziński, W., Mrowiński, P., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Reithmaier, J.P., Höfling, S., Forchel, A.
Exciton and biexciton dynamics in single self-assembled InAs/InGaAlAs/InP quantum dash emitting near 1.55 µm
(2013) Applied Physics Letters, 103 (25), art. no. 253113.
Cytowania: 21 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,515
Projekt i konstrukcja układu pomiarowego, udział w przygotowaniu manuskryptu

11. Syperek, M., Dusanowski, Ł., Andrzejewski, J., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Misiewicz, J., Lelarge, F.
Carrier relaxation dynamics in InAs/GaInAsP/InP(001) quantum dashes emitting near 1.55 µm
(2013) Applied Physics Letters, 103 (8), art. no. 083104.
Cytowania: 16 Punktacja MNiSW: 40 Impact Factor: 3,515
Projekt i konstrukcja układu pomiarowego, udział w przygotowaniu manuskryptu

12. Rudno-Rudziski, W., Sek, G., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Lelarge, F., Rousseau, B.
Electronic structure and optical properties of 1.55 µm emitting InAs/InGaAsP quantum dash tunnel injection structures
(2012) Semiconductor Science and Technology, 27 (10), art. no. 105015.
Cytowania: 7 Punktacja MNiSW: 30 Impact Factor: 1,921
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

13. Syperek, M., Andrzejewski, J., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Influence of electronic coupling on the radiative lifetime in the (In,Ga)As/GaAs quantum dot-quantum well system
(2012) Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 85 (12), art. no. 125311.
Cytowania: 22 Punktacja MNiSW: 35 Impact Factor: 3,767
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

14. Syperek, M., Leszczyński, P., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Carrier transfer in the GaAs-based tunnel injection quantum well-quantum dots structures
(2011) AIP Conference Proceedings, 1399, pp. 571-572.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: brak
Wykonanie pomiarów fotoluminescencji

15. Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Sęk, G., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
Carrier wavefunction control in a dilute nitride-based quantum well - A quantum dot tunnel injection system for 1.3 µm emission
(2011) Semiconductor Science and Technology, 26 (8), art. no. 085004.
Cytowania: 3 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 1,723
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

16. Rudno-Rudziński, W., Andrzejewski, J., Sęk, G., Syperek, M., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Tunnel injection structures based on InGaAs/GaAs quantum dots: Optical properties and energy structure

(2010) Journal of Physics: Conference Series, 244, art. no. 012047.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: brak
Wykonanie pomiarów fotoodbicia, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi, przygotowanie manuskryptu

17. Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Sęk, G., Syperek, M., Misiewicz, J., Pavelescu, E.-M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Optical methods used to optimize semiconductor laser structures with tunnel injection from quantum well to InGaAs/GaAs quantum dots
(2009) Optica Applicata, 39 (4), pp. 923-932.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 13 Impact Factor: 0,358
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

18. Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Ryczko, K., Syperek, M., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
Room temperature free carrier tunneling in dilute nitride based quantum well - Quantum dot tunnel injection system for 1.3 µm
(2009) Applied Physics Letters, 94 (17), art. no. 171906.
Cytowania: 24 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 3,554
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

19. Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Ryczko, K., Syperek, M., Misiewicz, J., Semenova, E.S., Lemaitre, A., Ramdane, A.
Optical properties and energy transfer in InGaAsN quantum well InAs quantum dots tunnel injection structures for 1.3 µm emission
(2009) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 206 (5), pp. 826-829.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 27 Impact Factor: 1,228
Praca w cyklu, wkład opisany powyżej

20. Chouaib, H., Bru-Chevallier, C., Apostoluk, A., Rudno-Rudzinski, W., Pelouard, J.-L., Lijadi, M., Bove, P.
Photoreflectance spectroscopy for the qualification of GaAsSb alloys introduced in ultrafast heterojunction bipolar transistors on InP
(2009) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 206 (5), pp. 786-790.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 27 Impact Factor: 1,228
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia

21. Chouaib, H., Rudno-Rudzinski, W., Apostoluk, A., Bru-Chevallier, C., Lijadi, M., Bove, P.
Surface fermi level in GaAsSb alloys grown by MBE on InP substrates
(2008) Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials, art. no. 4703020.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: brak
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia

22. Chouaib, H., Bru-Chevallier, C., Apostoluk, A., Rudno-Rudzinski, W., Lijadi, M., Bove, P.
Surface Fermi level in GaAsSb structures grown by molecular beam epitaxy on InP substrates
(2008) Applied Physics Letters, 93 (4), art. no. 041913.
Cytowania: 7 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 3,762
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia, udział w przygotowaniu manuskryptu

23. Sęk, G., Podemski, P., Rudno-Rudziński, W., Gumienny, Z., Misiewicz, J.
Microphotoreflectance spectroscopy - A modulation technique with high spatial resolution

(2007) Optica Applicata, 37 (4), pp. 439-448.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 13 Impact Factor: 0,284
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji w skali makro

24. Motyka, M., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Kudrawiec, R., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance and contactless electroreflectance of an InAs quantum dash laser structure
(2007) Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 4 (2), pp. 350-352.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 2 Impact Factor: brak
Wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia

25. Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Misiewicz, J., Lamas, T.E., Quivy, A.A.
The formation of self-assembled InAs/GaAs quantum dots emitting at 1.3 µm followed by photoreflectance spectroscopy
(2007) Journal of Applied Physics, 101 (7), art. no. 073518.
Cytowania: 26 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 2,171
Pomysł badań, wykonanie i analiza pomiarów fotoodbicia, przygotowanie manuskryptu

26. Sęk, G., Kudrawiec, R., Motyka, M., Poloczek, P., Rudno-Rudziński, W., Podemski, P., Misiewicz, J.
Contactless modulated reflectivity of quasi 0D self-assembled semiconductor structures
(2007) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 204 (2), pp. 400-411.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 27 Impact Factor: 1,214
Wykonanie pomiarów fotoodbicia

Poniżej przed doktoratem

1. Rudno-Rudziński, W., Kudrawiec, R., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance investigations of energy level structure of InAs quantum dashes embedded in InGaAs/InGaAlAs quantum well grown on InP substrate
(2006) Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 3 (11), pp. 3852-3855.
Cytowania: 0 Punktacja MNiSW: 2 Impact Factor: brak
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, przygotowanie manuskryptu

2. Rudno-Rudziński, W., Kudrawiec, R., Podemski, P., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance-probed excited states in InAs/InGaAlAs quantum dashes grown on InP substrate
(2006) Applied Physics Letters, 89 (3), art. no. 031908.
Cytowania: 38 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 3,977
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, przygotowanie manuskryptu

3. Rudno-Rudziński, W., Kudrawiec, R., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance investigation of InAs quantum dashes embedded in $In_{0.53}Ga_{0.47}As/In_{0.53}Ga_{0.23}Al_{0.24}As$ quantum well grown on InP substrate
(2006) Applied Physics Letters, 88 (14), art. no. 141915.
Cytowania: 13 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 3,977
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, przygotowanie manuskryptu

4. Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Sęk, G., Misiewicz, J., Da Silva, M.J., Quivy, A.A.

Photoreflectance study of energy level structure of self-assembled InAs/GaAs quantum dots emitting at 1.3 µm
(2005) Solid State Communications, 135 (4), pp. 232-236.
Cytowania: 5 Punktacja MNiSW: 27 Impact Factor: 1,489
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi, przygotowanie manuskryptu

5. Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Ryczko, K., Kudrawiec, R., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Optically probed wetting layer in InAs/InGaAlAs/InP quantum-dash structures
(2005) Applied Physics Letters, 86 (10), art. no. 101904, pp. 1-3.
Cytowania: 26 Punktacja MNiSW: 32 Impact Factor: 4,127
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, powiązanie wyników spektroskopowych z obliczeniami numerycznymi, przygotowanie manuskryptu

6. Rudno-Rudzinski, W., Kudrawiec, R., Misiewicz, J., Derluyn, J., Moerman, I.
Influence of TBAs flow in MOCVD growth on nitrogen incorporation in GaAsN alloy and its optical quality detected by photoreflectance
(2004) Physica Status Solidi C: Conferences, 1 (2), pp. 329-332.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: brak
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji, współpraca przy przygotowaniu manuskryptu

7. Kudrawiec, R., Sęk, G., Rudno-Rudziński, W., Misiewicz, J., Wojcik, J., Robinson, B.J., Thompson, D.A., Mascher, P.
Investigation of dielectric cap induced intermixing of $In_xGa_{1-x}As_yP_{1-y}$/InP quantum well laser structures by photoreflectance and photoluminescence
(2003) Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 101 (1-3), pp. 137-141.
Cytowania: 6 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: 1,070
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji

8. Kudrawiec, R., Sęk, G., Rudno-Rudziński, W., Misiewicz, J., Wojcik, J., Robinson, B.J., Thompson, D.A., Mascher, P.
Photoreflectance study of changes in the QW profile of 1.55-micrometer laser structure induced by SiO_2 cap layers
(2003) Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 101 (1-3), pp. 232-235.
Cytowania: 2 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: 1,070
Wykonanie pomiarów fotoodbicia

9. Derluyn, J., Moerman, I., Leys, M.R., Patriarche, G., Sek, G., Kudrawiec, R., Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Misiewicz, J.
Control of nitrogen incorporation in Ga(ln)NAs grown by metalorganic vapor phase epitaxy
(2003) Journal of Applied Physics, 94 (4), pp. 2752-2754.
Cytowania: 10 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: 2,171
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji

10. Kudrawiec, R., Sek, G., Ryczko, K., Rudno-Rudziński, W., Misiewicz, J., Wojcik, J., Robinson, B.J., Thompson, D.A., Mascher, P.
Photoreflectance study of the interdiffusion effects in the InGaAsP-based quantum well laser structures

(2003) Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 17 (1-4), pp. 602-603.
Cytowania: 4 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: 0,930
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji

11. Kudrawiec, R., Sęk, G., Rudno-Rudziński, W., Misiewicz, J., Wojcik, J., Robinson, B.J., Thompson, D.A., Mascher, P.
Investigation of the non-square InGaAsP/InP quantum wells in the electric field by photoreflectance
(2002) Acta Physica Polonica A, 102 (4-5), pp. 649-657.
Cytowania: 8 Punktacja MNiSW: 0 Impact Factor: 0,345
Wykonanie pomiarów fotoodbicia i fotoluminescencji

2. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

Wystąpienia ustne

- The 6th International Workshop on the Optical Properties of Nanostructures (OPON2020) 2020, Warszawa „Excitons in new generation of symmetric InAs/InP quantum dots: single photon emission and influence of external magnetic field”
- International Conference on Optics of Excitons in Confined Systems 2019, St. Petersburg, Rosja „High symmetry InAs/InP quantum dots for 1.55 µm single photon source”
- E-MRS Spring Meeting and Exhibit 2017, Strasbourg, Francja „Control of coupling and emission dynamics in InAs/InAlGaAs/InP hybrid quantum well-quantum dot structures emitting at 1.55 µm”
- Krajowa Konferencja Elektroniki 2017, Darłówek „Struktury tunelowe studnia kwantowa-kropki kwantowe jako ośrodek czynny laserów telekomunikacyjnych”
- XI Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 2009, Szklarska Poręba, „Własności optyczne obszaru aktywnego laserów półprzewodnikowych ze wstrzykiwaniem tunelowym ze studni do kropek kwantowych InGaAs/GaAs”
- 2nd Semiconductor Laser Workshop 2008 Kazimierz Dolny „Quantum dot based tunnel injection structures for application in telecommunication lasers”
- 3rd International Workshop on Modulation Spectroscopy of Semiconductor Structures, Wrocław 2008 „Optical properties and energy transfer in InGaAsN quantum well – InAs quantum dots tunnel injection structures for 1.3 µm emission”

Poniżej przed doktoratem

- X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, Szklarska Poręba 2005 „Optyczne własności struktur z kreskami kwantowymi przeznaczonych do zastosowań telekomunikacyjnych”
- NanoSympozjum 2004, PAN, Wrocław, „Badanie własności optycznych samorosnących kropek kwantowych metodą fotoodbicia i fotoluminescencji.”
- Konferencja Naukowa Studentów, 2004, PWr, „Procesy absorpcyjne i rekombinacyjne w strukturach z kropkami i kreskami kwantowymi.”

Wystąpienia plakatowe

- Quantum devices for non-classical light generation and manipulation 2019, Erice, Włochy „High symmetry InAs/InP quantum dots for 1.55 µm single photon source”
- 46 International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2017”, Szczyrk „Dynamic and polarisation properties of InAs/InAlGaAs/InP hybrid quantum well-quantum dot structures emitting at 1.55 µm”
- XIII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 2015, Szklarska Poręba „Design and optical properties of InP-based quantum well-quantum dot tunnel injection structures for applications in telecommunication lasers”
- 44 International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2015”, Wisła „Optical Properties of Molecular-beam-epitaxy-grown InAs/InAlGaAs/InP Quantum Dots as 1.55 µm Emitters in Tunnel Injection Lasers”
- International Conference on Optics of Excitons in Confined Systems 2013, Rzym, Włochy „Probing the exciton confinement regime in InAs/InGaAlAs/InP quantum dashes emitting at the telecommunication wavelengths”
- 42 International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2013”, Wisła „Dispersion of lifetimes and confinement regime in InAs/InGaAlAs/InP quantum dashes emitting at telecommunication wavelengths”
- XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 2012, Szklarska Poręba „Experimental and theoretical investigations of coupling strength in the (In,Ga)As/GaAs quantum well-quantum dot tunnel injection system”
- Quantum Dot 2010, Nottingham, Wielka Brytania „Tunnel injection structures based on InGaAs/GaAs quantum dots: optical properties and energy structure”
- XXXVIII International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2009”, „Influence of tunnelling on optical properties of InGaAs/GaAs quantum dot based tunnel injection structures”

Poniżej przed doktoratem

- XXXV International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2006”, 2006 „Photoreflectance investigations of InAs/InP Quantum dash energy structure.”, “2D-3D Growth Transition in Self-assembled InAs/GaAs Quantum Dot Structures Followed by Photoreflectance Spectroscopy”
- 4th International Conference on Quantum Dots, Chamonix, Francja 2006 "Photoreflectance investigations of energy level structure in InAs/InGaAlAs quantum dashes grown on InP substrate"
- XXXIV International School on the Physics of Semiconducting Compounds “Jaszowiec 2005”, 2005 “Optical Properties of InAs/InGaAlAs/InP Quantum-Dash Structures”
- Workshop on Nanospintronics, Warszawa/Wrocław 2005, "Photoreflectance investigation of energy level structure of InAs quantum dashes embedded in InGaAs/InGaAlAs quantum well grown on InP substrate"
- SPIE Annual Meeting, Denver, USA 2004 “Modulation spectroscopy of InAs/GaAs quantum dot structures.”

- 27th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 27), Flagstaff, USA 2004 “Modulation spectroscopy of InAs/GaAs quantum dot structures.”
- E-MRS Fall Meeting, Warszawa 2003 “Correlation between nitrogen incorporation and optical quality in MOCVD-grown Ga(In)NAs investigated by photoluminescence and modulation spectroscopy.”
- XXXII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec 2003 “Photoluminescence and Photoreflectance of GaInAsN/GaAs Quantum Wells with Step-like Barriers”.

3. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji.

- Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki, Wrocław 2018, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- 44. Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław 2017, Komitet Organizacyjny - Skarbnik
- 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems (EP2DS-20) and 16th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-16), Wrocław 2013; Komitet Organizacyjny konferencji – obsługa finansowa

Poniżej przed doktoratem

- Konferencja „Modulation Spectroscopy of Semiconductor Structures”, Wrocław 2004, Komitet Organizacyjny

4. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

- 2020-2022, projekt NCN OPUS „Właściwości optyczne, strukturalne i elektroniczne kropek kwantowych III-V na krzemie”, wykonawca
- 2018-2020, projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe „Partnerstwa Akademickie Politechniki Wrocławskiej”
- 2018-2020, projekt FNP HOMING „Quantum dot-based indistinguishable and entangled photon sources at telecom wavelengths”, pracownik B+R
- 2014 – 2018, projekt NCN HARMONIA „Badania podstawowych własności fizycznych układów sprzężonych studnia kwantowa - kropka kwantowa emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni 1,3 - 1,55 mikrometra”, wykonawca
- 2012 – 2017, projekt NCN MAESTRO „Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania”, wykonawca
- 2011 – 2014, projekt NCN OPUS „Badania kompleksów ekscytonowych w zero-wymiarowych strukturach nowego typu z wykorzystaniem spektroskopii korelacyjnej w zakresie bliskiej podczerwieni powyżej 1 µm.”, wykonawca
- 2010 – 2012, projekt własny NCN „Optyczne badania zjawisk fizycznych w strukturach tunelowych związków III - V zawierających kropki kwantowe”, wykonawca

5. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach.

Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego SPIE

Prezes Studenckiego Koła Naukowego SPIE 2004-2005

SPIE 2004-2007

Polskie Towarzystwo Fizyczne od 2012 r.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF od 2014 r

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej od 2015 r.

Sekretarz Oddziału Wrocławskiego PTF od 2016 r.

6. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

Dwa miesięczne staże w Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, Groupe d'Optique Nonlinéaire et d'Optoélectronique, CNRS-ULP-EHICS, Strasbourg, Francja, 2005 – 2006

Staż po-doktorski w Institut National des Sciences Appliquées, Lyon, Francja, 09.2006 – 06.2007

Tygodniowy staż naukowy – konsultacje, Center for Quantum Materials and Technology, Eindhoven University of Technology, 2010

Staż krótkoterminowy w Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin, sierpień 2019

7. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych.

Recenzje prac naukowych w następujących czasopismach:

Semiconductor Science and Technology (3)

Journal of Physics: Condensed Matter (1)

Journal of Physics and Chemistry of Solids (4)

Optical Materials (1)

Chinese Optics Letters (1)

Applied Physics Letters (1)

The Journal of Physical Chemistry (1)

Journal of Physics and Chemistry of Solids (2)

Nanoscale Research Letters (1)

Optica Applicata (1)

8. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych.

- 2008–2011 „Development of low-cost technologies for the fabrication of high-performance telecommunication lasers (DeLight)", 7. Program Ramowy UE
- 2005-2008 „Zero Order Dimension based Industrial components Applied to teleCommunications (ZODIAC)", 6. Program Ramowy UE

Poniżej przed doktoratem

- 2000-2003 "GaAs-based emitters for fibre-optical data and telecommunications (GIFT)" 5. Program Ramowy UE

9. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone w pkt. II.9.

2006-2008 projekt ATTHENA, French National Research Agency (ANR) „Antimoine pour TBH THz optimisé pour une ÉlectroNique Analogique"

10. Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny.

Recenzja grantu NCN

III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM

1. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym.

Większość prowadzonych przeze mnie badań naukowych dotyczy własności fizycznych nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych służących jako podstawa konstrukcji przyrządów optoelektronicznych mających zastosowanie w telekomunikacji światłowodowej, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciego okna telekomunikacyjnego. Uzyskane wyniki stanowią wstępny etap w rozwoju nowych urządzeń. Największe przełożenie na praktyczne zastosowania miały prace badawcze prowadzone w projektach europejskich, we współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi.

W przypadku projektu **GIFT** członkami konsorcjum ze strony sektora gospodarczego byli:

- OPTO+ Francja
- FRANCE TÉLÉCOM – CNET Francja
- MITEL SEMICONDUCTOR AB Szwecja
- NANOPLUS NANOSYSTEMS AND TECHNOLOGIES GmbH Niemcy

Celem projektu GIFT było zastąpienie technologii wytwarzania struktur półprzewodnikowych na podłożach InP technologią opartą na GaAs, co zredukowałoby koszt wytwarzania laserów do zastosowań telekomunikacyjnych. Osiągnięto rezultaty będące światowymi rekordami, w tym najnowocześniejszy laser emitujący przy 1,3 µm i lasery legitymujące się najlepszymi parametrami pracy dla dalszych długości fal. Wiele prac dotyczących nowych materiałów oraz nowatorskich rozwiązań przyrządowych miało charakter pionierski.

W wyniku prac w projekcie powstały następujące publikacje, których jestem autorem/współautorem

Derluyn, J., Moerman, I., Leys, M.R., Patriarche, G., Sek, G., Kudrawiec, R., Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Misiewicz, J.
Control of nitrogen incorporation in Ga(ln)NAs grown by metalorganic vapor phase epitaxy
(2003) Journal of Applied Physics, 94 (4), pp. 2752-2754.

W przypadku projektu **ZODIAC** członkami konsorcjum ze strony sektora gospodarczego byli:

- ALCATEL THALES III V LAB LASERS DEPT Francja
- NANOPLUS NANOSYSTEMS AND TECHNOLOGIES GMBH Niemcy
- BOOKHAM TECHNOLOGY PLC Wielka Brytania
- NL NANOSEMICONDUCTOR GMBH Niemcy

Poprawa technologii wzrostu umożliwiła wytworzenie najlepszych bezpośrednio modulowanych laserów na bazie kropek kwantowych emitujących przy 1,3 µm i 1,55 µm, o parametrach pracy (czułość na temperaturę, szerokość pasma modulacji) co najmniej dorównujących, a często przewyższających parametry laserów studniowych. Pokazano urządzenia niechłodzone i niewymagające izolatorów optycznych, o kosztach produkcji zdecydowanie niższych niż przy laserach wykorzystywanych typowo. Skonstruowano również lasery przestrajalne w szerokim zakresie oraz szerokopasmowe wzmacniacze optyczne, o jakości odpowiadającej produkcji przemysłowej. Udowodniono, że technologia kropek kwantowych jest właściwa dla przemysłowej produkcji przyrządów telekomunikacyjnych. Poza rezultatami przyrządowymi, przeprowadzone badania pozwoliły zrozumieć własności struktur tunelowych z kropkami kwantowymi oraz pokazały obiecujące możliwości kontroli stanu polaryzacji światła emitowanego przez struktury 0D.

W wyniku prac w projekcie powstały następujące publikacje, których jestem autorem/współautorem

Rudno-Rudziński, W., Kudrawiec, R., Podemski, P., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance-probed excited states in InAs/InGaAlAs quantum dashes grown on InP substrate
(2006) Applied Physics Letters, 89 (3), art. no. 031908.

Rudno-Rudziński, W., Kudrawiec, R., Sęk, G., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance investigations of energy level structure of InAs quantum dashes embedded in InGaAs/InGaAlAs quantum well grown on InP substrate
(2006) Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 3 (11), pp. 3852-3855.

Sęk, G., Kudrawiec, R., Motyka, M., Poloczek, P., Rudno-Rudziński, W., Podemski, P., Misiewicz, J.
Contactless modulated reflectivity of quasi 0D self-assembled semiconductor structures
(2007) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 204 (2), pp. 400-411.

Motyka, M., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Kudrawiec, R., Misiewicz, J., Somers, A., Schwertberger, R., Reithmaier, J.P., Forchel, A.
Photoreflectance and contactless electroreflectance of an InAs quantum dash laser structure
(2007) Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 4 (2), pp. 350-352.

W przypadku projektu **DeLight** członkami konsorcjum ze strony sektora gospodarczego byli:

- III-V LAB, ALCATEL-THALES Francja
- MODULIGHT Inc. Finlandia
- MERGE OPTICS GmbH Niemcy

Urządzenia rozwinięte w ramach projektu DeLight mogą stać się kluczowymi składnikami przyszłych systemów przesyłu danych wysokiej szybkości. Połączenie bezpośredniej modulacji, szerokiego pasma i niskich kosztów produkcji laserów telekomunikacyjnych może poprawić dostęp do obecnie oferowanych usług sieciowych, jaki również otworzy możliwości rozwoju nowych aplikacji, obecnie niepraktycznych.

W wyniku prac w projekcie powstały następujące publikacje, których jestem autorem/współautorem

Rudno-Rudziński, W., Ryczko, K., Sęk, G., Syperek, M., Misiewicz, J., Pavelescu, E.-M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Optical methods used to optimize semiconductor laser structures with tunnel injection from quantum well to InGaAs/GaAs quantum dots
(2009) Optica Applicata, 39 (4), pp. 923-932.

Rudno-Rudziński, W., Andrzejewski, J., Sęk, G., Syperek, M., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.

Tunnel injection structures based on InGaAs/GaAs quantum dots: Optical properties and energy structure
(2010) Journal of Physics: Conference Series, 244, art. no. 012047.

Syperek, M., Leszczyński, P., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Andrzejewski, J., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Carrier transfer in the GaAs-based tunnel injection quantum well-quantum dots structures
(2011) AIP Conference Proceedings, 1399, pp. 571-572.

Syperek, M., Andrzejewski, J., Rudno-Rudziński, W., Sęk, G., Misiewicz, J., Pavelescu, E.M., Gilfert, C., Reithmaier, J.P.
Influence of electronic coupling on the radiative lifetime in the (In,Ga)As/GaAs quantum dot-quantum well system
(2012) Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 85 (12), art. no. 125311.

IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE (zgodnie z bazą Scopus)

1. Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach, w których parametr ten jest powszechnie używany jako wskaźnik naukometryczny).

Suma Impact Factor (całość): 68,784

2. Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzględnieniem autocytowań.

304 (39 autocytowań)/126 z wyłączeniem wszystkich autorów

3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.

10

4. Informacja o liczbie punktów MNiSW.

756

.....
(podpis wnioskodawcy)